

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 27 年 2 月 5 日 (2015.2.5)

【公開番号】特開 2012-235106 (P2012-235106A)

【公開日】平成 24 年 11 月 29 日 (2012.11.29)

【年通号数】公開・登録公報 2012-050

【出願番号】特願 2012-95280 (P2012-95280)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/8242 (2006.01)

H 0 1 L 27/108 (2006.01)

H 0 1 L 21/8244 (2006.01)

H 0 1 L 27/11 (2006.01)

H 0 1 L 21/8247 (2006.01)

H 0 1 L 27/115 (2006.01)

H 0 1 L 27/105 (2006.01)

H 0 1 L 27/10 (2006.01)

H 0 1 L 29/788 (2006.01)

H 0 1 L 29/792 (2006.01)

H 0 1 L 21/28 (2006.01)

H 0 1 L 29/417 (2006.01)

H 0 1 L 29/423 (2006.01)

H 0 1 L 29/49 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 29/78 6 2 6 C

H 0 1 L 29/78 6 1 8 B

H 0 1 L 29/78 6 1 7 S

H 0 1 L 29/78 6 1 8 C

H 0 1 L 29/78 6 1 7 K

H 0 1 L 27/10 3 2 1

H 0 1 L 27/10 3 8 1

H 0 1 L 27/10 4 3 4

H 0 1 L 27/10 6 1 5

H 0 1 L 27/10 6 7 1 C

H 0 1 L 27/10 6 7 1 Z

H 0 1 L 27/10 4 4 1

H 0 1 L 27/10 4 8 1

H 0 1 L 29/78 3 7 1

H 0 1 L 21/28 3 0 1 B

H 0 1 L 29/50 M

H 0 1 L 29/58 G

【手続補正書】

【提出日】平成 26 年 12 月 11 日 (2014.12.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

絶縁層と、酸化物半導体膜と、を有し、
前記絶縁層は、曲面を有する領域を有し、
前記酸化物半導体膜は、前記絶縁層の曲面に接する第 1 の領域を有し、
前記第 1 の領域は、前記絶縁層の曲面に概略垂直な c 軸を有する結晶を有することを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】

絶縁層と、酸化物半導体膜と、を有し、
前記絶縁層は、曲面を有する領域を有し、
前記酸化物半導体膜は、前記絶縁層の曲面に接する第 1 の領域を有し、
前記第 1 の領域は、前記絶縁層の曲面に概略垂直な c 軸を有する結晶を有し、
前記結晶は、前記絶縁層の曲面に沿った層状構造を有することを特徴とする半導体装置

。

【請求項 3】

絶縁層と、酸化物半導体膜と、を有し、
前記絶縁層は、複数のトレンチを有し、
前記トレンチは、下端に曲面を有する領域を有し、
前記酸化物半導体膜は、前記絶縁層の曲面に接する第 1 の領域を有し、
前記第 1 の領域は、前記絶縁層の曲面に概略垂直な c 軸を有する結晶を有し、
前記結晶は、前記絶縁層の曲面に沿った層状構造を有することを特徴とする半導体装置

。

【請求項 4】

請求項 1 乃至 3 のいずれかーにおいて、
前記絶縁層の曲面は、20 nm 以上 60 nm 以下の曲率半径を有することを特徴とする半導体装置。